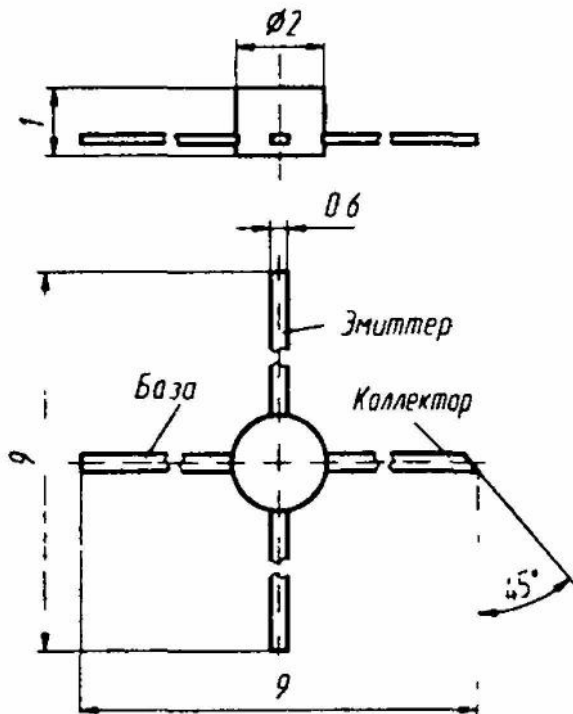


**2Т3132А-2, 2Т3132Б-2, 2Т3132В-2, 2Т3132Г-2,
2Т3132А-5, КТ3132А-2, КТ3132Б-2, КТ3132В-2,
КТ3132Г-2, КТ3132Д-2, КТ3132Е-2**



Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры *n-p-n* усилительные с нормированным коэффициентом шума. Предназначены для применения в СВЧ малоомощных усилителях диапазона частот 1...7,2 ГГц герметизированной аппаратуры. Бескорпусные на кристаллодержателе с гибкими выводами. Транзистор 2Т3132А-5 выпускается в виде кристаллов без кристаллодержателя и без выводов. Тип прибора указывается в этикетке. На транзистор наносится условная маркировка двумя точками (точка у базового вывода и точка у коллекторного вывода): КТ3132А-2 — синие,

КТ3132Б-2 — красные, КТ3132В-2 — желтые, КТ3132Г-2 — бежевые, КТ3132Д-2 — белые, КТ3132Е-2 — зеленые.

Масса транзистора в держателе не более 0,2 г, кристалла — не более 0,002 г.

Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при $U_{КБ} = 7$ В, $I_3 = 5$ мА:

2Т3132А-2, 2Т3132Б-2, 2Т3132В-2, 2Т3132Г-2, 2Т3132А-5, КТ3132А-2, КТ3132Б-2, КТ3132В-2, КТ3132Г-2	15...100*...150*
КТ3132Д-2	20...100*...150*
КТ3132Е-2	70...100*...150*

Граничная частота коэффициента передачи тока при $I_3 = 3$ мА, $U_{КБ} = 7$ В	5,5...6,5*... 7*ГГц
---	------------------------

Коэффициент шума при $U_{КБ} = 7$ В:

$f = 6$ ГГц: 2Т3132Б-2, $I_3 = 5$ мА	3,9*...4,3*...5 дБ
---	--------------------

КТ3132Б-2, $I_3 = 5$ мА	4,2*...4,4*... 4,8 дБ
$f = 5$ ГГц:	
2Т3132В-2, $I_3 = 5$ мА	4,1*...4,5*...5 дБ
КТ3132В-2, $I_3 = 5$ мА	4,3*...4,4*... 4,8 дБ
$f = 4$ ГГц:	
2Т3132Г-2, $I_3 = 5$ мА	3,1*...3,3*... 3,6 дБ
КТ3132Г-2, $I_3 = 5$ мА	3*...3,1*... 3,45 дБ
$f = 3,6$ ГГц:	
2Т3132А-2, 2Т3132А-5, $I_3 = 3$ мА	2,2*...2,3*... 2,5 дБ
КТ3132А-2, $I_3 = 3$ мА	1,8*...2*... 2,4 дБ
$f = 2,25$ ГГц:	
2Т3132А-2, 2Т3132А-5, $I_3 = 3$ мА	1,5*...1,8*...2 дБ
КТ3132А-2, $I_3 = 3$ мА	1,5*...1,7*... 1,9 дБ
КТ3132Д-2, $I_3 = 3$ мА	1,5*...1,7*...2 дБ
КТ3132Е-2, $I_3 = 3$ мА	1,79*...2,4*... 2,5 дБ
Коэффициент усиления по мощности при $U_{кб} = 7$ В:	
$f = 6$ ГГц:	
2Т3132Б-2, $I_3 = 5$ мА	4...5,3*...6* дБ
КТ3132Б-2, $I_3 = 5$ мА	4,3...5,2*... 5,8* дБ
$f = 5$ ГГц:	
2Т3132В-2, $I_3 = 5$ мА	5...6,7*...8* дБ
КТ3132В-2, $I_3 = 5$ мА	5,6...6,1*... 6,6* дБ
$f = 4$ ГГц:	
2Т3132Г-2, $I_3 = 5$ мА	6...6,9*...7,4* дБ
КТ3132Г-2, $I_3 = 5$ мА	7...7,8*...8,5* дБ
$f = 3,6$ ГГц:	
2Т3132А-2, 2Т3132А-5, $I_3 = 3$ мА	6...7,5*...8,2* дБ
КТ3132А-2, $I_3 = 3$ мА	6,4...8,1*... 10* дБ
$f = 2,25$ ГГц:	
2Т3132А-2, 2Т3132А-5, $I_3 = 3$ мА	8...9,5*...10* дБ
КТ3132А-2, $I_3 = 5$ мА	8,1...8,8*... 9,5* дБ

КТ3132Д-2, $I_3 = 5$ мА	8,1...8,8*... 9,5* дБ
КТ3132Е-2, $I_3 = 5$ мА	8,1...9,8*... 10,9* дБ
Выходная мощность при снижении усиления на 1 дБ, $I_3 = 3$ мА, $U_{кб} = 7$ В, $f = 3,5$ ГГц	1,6*...1,7*... 1,9* мВт
Обратный ток коллектора при $U_{кб} = 10$ В, не более:	
$T = -60...+25$ °С	0,5 мкА
$T = +125$ °С	10 мкА
Обратный ток эмиттера при $U_{эб} = 1$ В, не более	20 мкА
Емкость коллекторного перехода при $U_{кб} = 7$ В	4,5*...5*...5,5 пФ
Емкость эмиттерного перехода при $U_{эб} = 0$...	0,85*...0,9*... 0,95 пФ

Предельные эксплуатационные данные

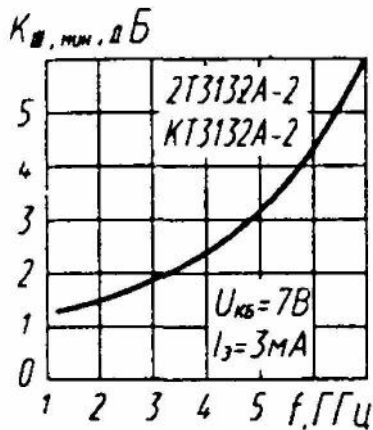
Постоянное напряжение коллектор—база	10 В
Постоянное напряжение коллектор—эмиттер при $R_{бэ} = 1$ кОм	10 В
Постоянное напряжение эмиттер—база	1 В
Постоянный ток коллектора	8,5 мА
Постоянная рассеиваемая мощность коллек- тора:	
при $T = -60...+85$ °С	70 мВт
при $T = +125$ °С	30 мВт
Непрерывная входная СВЧ мощность при $I_3 = 3$ мА, $U_{кб} = 7$ В, $T = +70$ °С	10 мВт
Импульсная входная СВЧ мощность при $t_{и} = 1,3$ мкс, $Q = 30$, $T = +65$ °С	50 мВт
Температура p - n перехода	+200 °С
Температура окружающей среды	-60...+125 °С

Допускается однократный изгиб выводов с радиусом 1,5 мм не ближе 1 мм от кристаллодержателя. Допускается обрезка выводов не ближе 1 мм от кристаллодержателя.

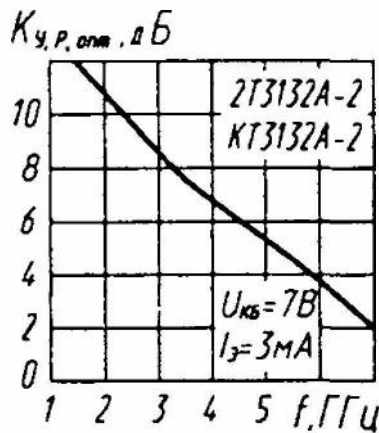
Монтаж транзистора 2Т3132А-5 осуществляется ультразвуковой пайкой с температурой +400...+450 °С. Выводы к контактным площадкам присоединяются сваркой при температуре +300 °С в течение 2...3 с.

Пайка выводов транзисторов 2Т3132А-2, 2Т3132Б-2, 2Т3132В-2, 2Т3132Г-2, КТ3132А-2, КТ3132Б-2, КТ3132В-2, КТ3132Г-2, КТ3132Д-2, КТ3132Е-2 допускается не ближе 1 мм от кристаллодержателя при температуре не выше +260 °С в течение времени не более 3 с и не ближе 0,2 мм от кристаллодержателя при температуре не выше +160 °С.

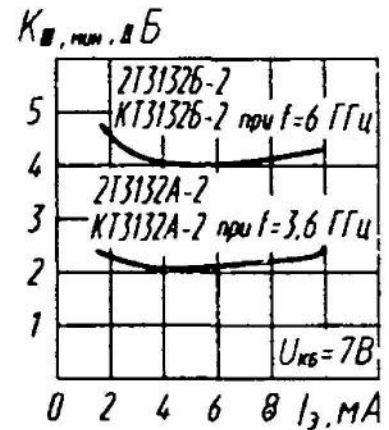
Допустимый статический потенциал 30 В.



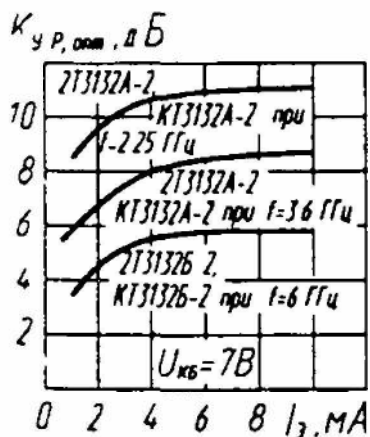
Зависимость коэффициента шума от частоты



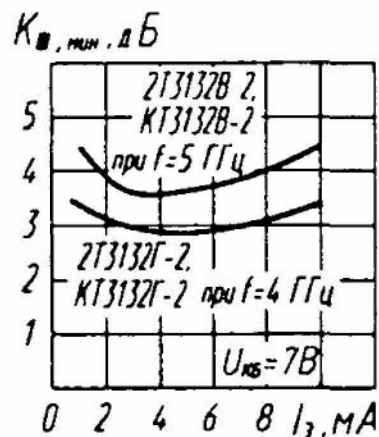
Зависимость коэффициента усиления от частоты



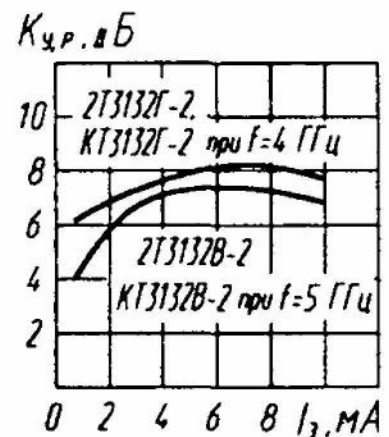
Зависимости коэффициента шума от тока эмиттера



Зависимости коэффициента усиления от тока эмиттера



Зависимости коэффициента шума от тока эмиттера



Зависимости коэффициента усиления от тока эмиттера